

查询"2SC3369"供应商  
**2SC3369**

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

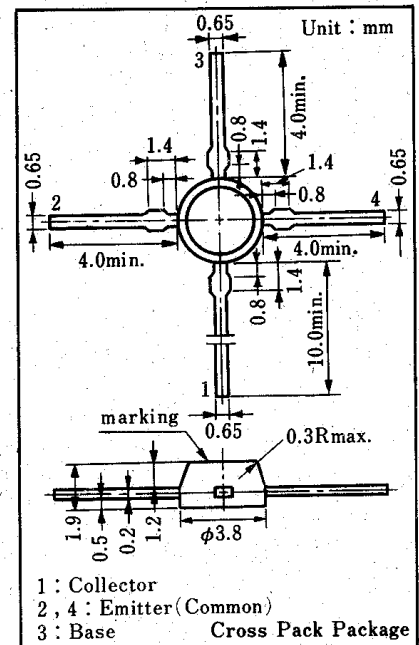
高周波電力増幅用 / RF Power Amplifier

■ 特徴 / Features

- 中出力である。 / Middle power output
- 高利得である。 / High gain

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

| Item              | Symbol           | Value      | Unit |
|-------------------|------------------|------------|------|
| コレクタ・エミッタ電圧       | V <sub>CEO</sub> | 16         | V    |
| コレクタ・エミッタ電圧       | V <sub>CES</sub> | 25         | V    |
| エミッタ・ベース電圧        | V <sub>EBO</sub> | 3          | V    |
| せん頭コレクタ電流         | I <sub>CP</sub>  | 0.5        | A    |
| コレクタ電流            | I <sub>C</sub>   | 0.3        | A    |
| コレクタ損失 (Tc=25 °C) | P <sub>C</sub>   | 1          | W    |
| 接合部温度             | T <sub>j</sub>   | 135        | °C   |
| 保存温度              | T <sub>stg</sub> | -55 ~ +135 | °C   |



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

| Item       | Symbol            | Condition   | min. | typ. | max. | Unit |
|------------|-------------------|---|------|------|------|------|
| コレクタ・シャ断電流 | I <sub>CBO</sub>  | V <sub>CB</sub> =20 V, I <sub>E</sub> =0                |      |      | 100  | μA   |
| エミッタ・シャ断電流 | I <sub>EBO</sub>  | V <sub>EB</sub> =2V, I <sub>C</sub> =0                  |      |      | 500  | μA   |
| 直流電流増幅率    | h <sub>FE</sub>   | V <sub>CE</sub> =10 V, I <sub>C</sub> =100 mA*2         | 20   |      |      |      |
| コレクタ出力容量   | C <sub>ob</sub>   | V <sub>CB</sub> =10 V, I <sub>E</sub> =0, f=1 MHz       |      |      | 6    | pF   |
| 高周波出力      | P <sub>O</sub> *1 | V <sub>CC</sub> =8 V, P <sub>in</sub> =45 mW, f=915 MHz | 250  | 300  |      | mW   |
| 熱抵抗        | ΔV <sub>BE</sub>  | V <sub>CB</sub> =10 V, I <sub>E</sub> =-100 mA, t=0.8 s |      |      | 80   | mV   |

\*1 エミッタ接地, \*2 パルス測定 / Pulse Test

